

### 关键指标

频率: DC~6GHz  
插入损耗: 1.4dB  
隔离度: 45dB  
工作电压: +5V  
控制电平: 0/+5V  
芯片尺寸: 1.55mm×1.55mm×0.1mm

### 产品简介

HG123KF-1 是一款 DC~6GHz 吸收式单刀双掷开关芯片, 采用 GaAs pHEMT 工艺制作, 插入损耗为 1.4dB, 隔离度为 45dB。

### 电性能 (T<sub>A</sub>=25°C, V<sub>dd</sub>=+5V)

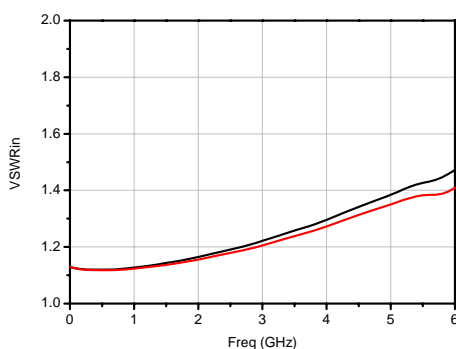
指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	DC~6		
输入驻波	-	1.4	-
输出驻波	-	1.6	-
插入损耗(dB)	-	1.4	-
隔离度(dB)	-	45	-

### 真值表

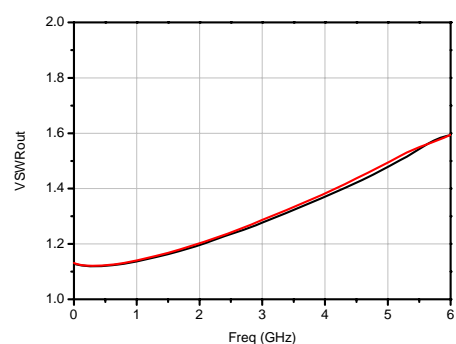
Ctrl	EN	RFC-RF1	RFC-RF2
5V	0V	ON	OFF
0V	0V	OFF	ON
0/5V	5V	OFF	OFF

### 典型测试曲线

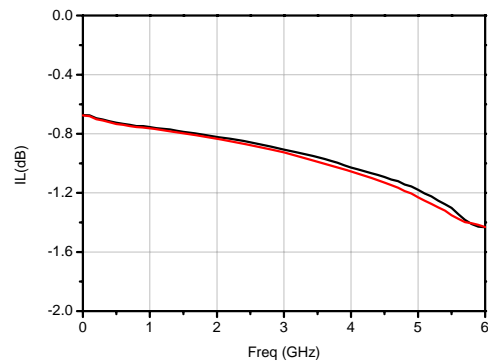
输入驻波



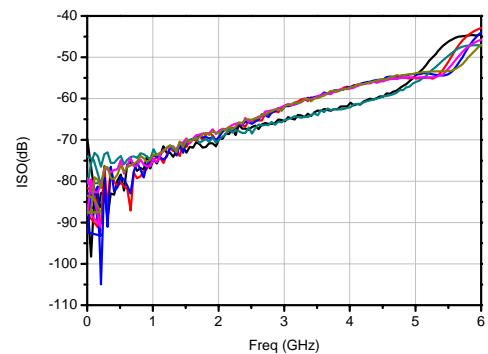
输出驻波



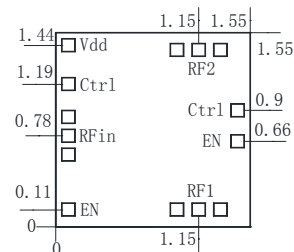
插入损耗



隔离度



### 外形和端口尺寸 (mm)



### 绝对额定最大值

最大输入功率	+27dBm	
工作电压	+5.5V	
控制电压	低电平: 0~0.5V	高电平: 3.3~5V
工作温度	-55°C~125°C	
存储温度	-65°C~150°C	

### 注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储, 在超净环境使用;
2. GaAs 材料较脆, 不能触碰芯片表面, 使用时必须小心;
3. 芯片用导电胶或合金烧结 (合金温度不能超过 300°C, 时间不能超过 30 秒), 使之充分接地;
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm, 使用 Φ25μm 双金丝键合, 建议金丝长度 250~400μm;
5. 芯片微波端无隔直电容;
6. 芯片对静电敏感, 在储存和使用过程中注意防静电。